

～弊社の主な製品の一覧表です。各種ウェハ径、膜種、膜厚に対応いたします。～

下記一覧表に記載が無いものでも、お客様のご要望に応じたウェハを提供しております。
お気軽にお問い合わせください。

- ベア Si ウェハ(100mm,150mm,200mm,300mm)
- 各種ブランケットウェハ(100mm,150mm,200mm,300mm)
-Cu, Ta/ TaN, W, Ti/ TiN, Al-Cu, SiN, PE-TEOS, HDP,
HARP oxide, Poly-Si, Th-Ox, ACL, SiC, SiON
- 各種 Low-k, ULK, High-k - 各種貴金属 Ru, Co, CoEP, Pt, Au
- 半導体樹脂材料 -Photo Resist, Polyimide, EMC, PBO
- 微細トレンチ, ホール ウェハ ●硝子 ウェハ ●シリコンウェハの各種分析も承ります。
- 各種パターンウェハ(100mm,150mm,200mm,300mm)
-MIT 854/754 パターン ウェハ (W, Mo, Co, Cu, Al),
-MIT 864/764 STI パターン, ILD パターンウェハ
-AMT STI パターン ウェハ (min.0.18um LS) -3D パターンウェハ
-KrF, ArF Litho, 液浸リソと Etched ウェハ
-High-dose Implanted ウェハ
-BUMP ウェハ, TSV テストウェハ, 低温 TEOS, 低温 SiN ウェハ
-Cu Hybrid Bonding ウェハ



アドバンスマテリアルズテクノロジー株式会社 <https://www.amti.co.jp>

英語名称 Advanced Materials Technology, Inc.
設立 1997年(平成9年)8月6日
会社ロゴ 
資本金 1,000万円
代表者 代表取締役会長 西本 豊樹 代表取締役社長 森木 泰次
本社所在地 〒811-3114 福岡県古賀市舞の里5丁目39番6号
TEL:092-943-7863 FAX:092-943-7812
福岡営業所所在地 〒810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号 上ノ橋ビル504号室
TEL:092-720-3681 FAX:092-720-3682
E-Mail: morikiy@amti.co.jp
物流倉庫所在地 〒813-0034 福岡市東区多の津1丁目10番6号 フォーサイト第2ビル1F
TEL:092-624-6773 FAX:092-624-6774
つくば事務所所在地 〒300-3257 茨城県つくば市筑穂2丁目9番4号 UNITE SOEMO 101号室
TEL:029-864-5801 FAX:029-864-5802
台湾分公司 302 中华民国台湾新竹县竹北市高铁七路65号13楼之9
TEL:+886-3-668-4975 FAX:+886-3-668-4976

AMT AMERICA, INC.

代表者 築瀬 充
本社所在地 Silicon Valley, California, U.S.A.
TEL: +1 (650) 814-8453
E-Mail : mitch@amti.co.jp

AMT KOREA, INC.

代表者 柳 在範
本社所在地 18462 大韓民国京畿道華城市東灘英川路150 ヒョンデシリコンアレー B棟 1622-1号
TEL:+82-10-9130-7503
E-Mail : yooj@amti.co.jp

アドバンスマテリアルズテクノロジー株式会社 テストウェハー製品カタログ



AMT 180nm STI Pattern Wafer

HDP Oxide complete filling into STI trenches

Center (0.18/0.18um)

Edge (0.18/0.18um)

AMT Proprietary

AMT 180nm SiN-on-Poly Pattern Wafer

LP-SiN complete filling into Poly trenches

Center (0.18/0.18um)

Edge (0.18/0.18um)

AMT Proprietary

AMT Custom BUMP Pattern Wafer

カスタムMASKを用いたパターンウェハ製作が可能です。
 ・レジストパターン付きウェハ
 ・Cuピラー形成など

AMT Proprietary

AMT 180nm W-CVD Pattern Wafer

Mass production technology of TiN/W-CVD fill

Center (180nm)

Center (250nm)

AMT Proprietary

AMT 180nm ECu Pattern Wafer

Mass production technology of ECu fill

Center (180nm)

AMT Proprietary

AMT 180nm ALD-Mo Pattern Wafer

Mo complete filling into TEOS trenches

180nm / 180nm

AMT Proprietary

AMT 3D ILD Pattern Wafer

Large Pattern (10um/3um)

Dense Pattern (10um/10um)

AMT Proprietary

AMT TSV Pattern Wafer - Process Steps

Top Field TEOS 550nm Via Middle

Corner Bottom

SACVD oxide liner fill

Top Field Ta 80nm Via Middle

Corner Bottom

Ta barrier fill

Top Field Cu seed fill

Corner Bottom

Cu electro-plating

AMT Proprietary

AMT Fine Trench Pattern Wafer

Center (60/60nm)

Edge (60/60nm)

Center (60/60nm)

Edge (60/60nm)

AMT Proprietary